

Тематический указатель статей, опубликованных в 1997 году

Фундаментальные исследования

Вульфсон А.Н. О некоторых приложениях термодинамики насыщенного пара к теории термоэлектронной эмиссии. № 2 стр. 25.

Зенкевич А.В., Хабелашвили И.Д., Неволин В.Н. Физические особенности импульсного лазерного осаждения металлов. № 2 стр. 3.

Романов В.П., Сапольков А.Ю., Букин М.С. Основы теории ионной дрейфово-диффузионной поляризации в диэлектриках. № 1 стр. 3.

Романов В.П., Золочевский Ю.Б., Сапольков А.Ю. Атомистический метод анализа ионных дрейфово-диффузионных процессов в диэлектриках. № 5 стр. 3.

Материалы электронной техники

Budagyan B.G., Metselaar J.W., Bauer G.H., Bosyakov M.N. New approaches to amorphous silikon fabrication and characterization for solar cells. № 3-4 стр. 11.

Авдеев С.П., Гаврилов А.Ю., Кулов С.К., Руденко А.А., Чередниченко Д.И. Вторично-эмиссионные характеристики свинцово-силикатного стекла после электронно-лучевой обработки в вакууме. № 3-4 стр. 28.

Айвазов А.А., Бодягин Н.В., Вихров С.П. Явления самоорганизации в технологиях твердотельных материалов. № 1 стр. 39.

Бодягин Н.В. Области критического состояния вещества в технологиях твердотельных материалов. № 2 стр. 31.

Бодягин Н.В., Вихров С.П., Айвазов А.А. Динамика роста твердотельных материалов. № 3-4 стр. 7.

Бодягин Н.В., Вихров С.П., Айвазов А.А. Причины невоспроизводимости структуры твердотельных материалов. № 5 стр. 9.

Будагян Б.Г., Айвазов А.А., Мейтин М.Н., Страхилев Д.А., Радосельский А.Г., Попов А.А., Черномордик В.Д., Мальшаков В.Г., Бердников А.Е. Перспективный метод получения аморфного кремния. № 2 стр. 44.

Будагян Б.Г., Сазонов А.Ю., Бердников А.Е., Попов А.А. Осаждение аморфного гидрогенизированного кремния в низкочастотном тлеющем разряде. № 3-4 стр. 19.

Булярский С.В., Светухин В.В., Приходько О.В., Романов И.М. Кинетика преципитации раствора кислорода в кремнии. № 5 стр. 24.

Годовицын И.В., Шелепин Н.А., Лыженкова Г.А. Формирование поверхностных микромеханических структур из пленок поликремния. № 2 стр. 49.

Гутарев В.В., Мочалкина О.Р., Орлова Л.К., Радецкая Н.В. Микропрофилирование пленок с высокотемпературной сверхпроводимостью. № 6 стр. 12.

Дикарев Ю.И., Цветков С.М., Суровцев И.С. Каталитическая активация серебром радикального травления диоксида кремния. № 2 стр. 39.

Кожитов Л.В., Крапухин В.В., Маленков Ю.Ю. Оптимизация толщины активной области гетерокомпозиций на основе $Al_xGa_{1-x}As$ мощных излучающих диодах. № 3-4 стр. 25.

Коркишко Ю.Н., Федоров В.А., Морозова Т.В., Носиков В.В. Фотоупругий эффект и особенности распространения света в протонообменных световодах в ниобате лития. № 6 стр. 3.

Королев М.А., Шумский И.А. Исследование генерации пустот в пленках рекристаллизованного кремния на диэлектрике. № 5 стр. 18.

Лучинин В.В., Таиров Ю.М. Карбид кремния - перспективный материал электронной техники. № 1 стр. 10.

Петров В.С., Зиборов А.А. Оценка концентрации занятых слабосвязанным кислородом вакансий в порошковом образце ВТСП типа иттрий-123. № 6 стр. 17.

Петрова В.З., Гребенькова В.И., Часовникова Е.В. Особенности характера спекания порошковых стеклокристаллических композиционных материалов. № 6 стр. 20.

Попов А.И., Лигачев В.А., Васильева Н.Д., Стукач С.Н. Комплексное исследование структурных особенностей гидрированных пленок углерода. № 3-4 стр. 3.

Руденко А.А., Чередниченко Д.И. Релаксация зарядового состояния в приповерхностном слое оптического стекла после электронно-лучевой обработки. № 5 стр. 12.

Соколов Е.Б., Прокофьева В.К., Беянина Е.В., Михайлова Н.М. Связь микротвердости со структурой монокристаллического кремния и распределением удельного электрического сопротивления. № 2 стр. 35.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Абрамов А.А. Влияние магнитного поля на отрицательное сопротивление S -типа при двойной инжекции носителей заряда в плоской pin -структуре. № 3-4 стр. 53.

Бакланов С.Б., Гурин Н.Т., Новиков С.Г. Моделирование планарно-диффузионных симисторов малой мощности и оптопар на их основе. № 6 стр. 49.

Бахрушин В.Е., Ольховой В.А., Пятигорец Р.А., Янус А.В. Моделирование и исследование процессов формирования переходной области полупроводниковых структур. № 6 стр. 44.

Блинов Ю.Ф., Серба П.В. Ионно-лучевое перемешивание в процессе роста и распыления пленок. № 3-4 стр. 44.

Вернер И.В., Корнеев В.И., Сауров А.Н. Особенности диффузии имплантированной примеси в структуре "поликремний на кремнии". № 3-4 стр. 39.

Галушков А.И., Чаплыгин Ю.А. Кремниевые магниточувствительные интегральные схемы. № 1 стр. 53.

Горлов М.И., Воронцов И.В. Экспериментальные исследования влияния электростатических разрядов на характеристики ИС. № 3-4 стр. 64.

Королев А.Н., Сеченов Д.А. Формирование приповерхностных легированных слоев при газофазной диффузии примеси. № 3-4 стр. 35.

Неволин В.К. Вольт-амперные характеристики квазиодномерных контактов S -типа. № 5 стр. 37.

Неволин В.К. Двухэлектродная элементная база наноэлектроники на основе квазиодномерных проводов. № 2 стр. 55.

- Новиков С.Г., Бакланов С.Б., Гурин Н.Т., Кудасов Г.В.** Трехтранзисторная модель планарно-диффузионного симистора. № 3-4 стр. 60.
- Панкратов О.В., Брехов Р.С., Погалов А.И., Шелепин Н.А.** Разработка и исследование интегральных пьезорезистивных акселерометров. № 1 стр. 57.
- Петров Б.К., Николаенков Ю.К.** Диффузионно-дрейфовая модель переходных процессов в биполярных транзисторах с изолированным затвором. № 2 стр. 58.
- Романов В.П., Золочевский Ю.Б., Ларчиков А.В., Сапольников А.Ю.** Влияние механических напряжений в диэлектрике на динамические вольт-амперные характеристики МДП-структур. № 6 стр. 37.
- Сауров А.Н.** Методы самоформирования в микроэлектронике. № 5 стр. 41.
- Сауров А.Н.** Специальные методы плазменного травления в технологии самоформирования. № 6 стр. 60.
- Сеченов Д.А., Варзарев Ю.Н., Милешко Л.П.** Особенности диффузии фосфора из анодной оксидной пленки в условиях быстрой термической обработки. № 5 стр. 48.
- Столяров А.А.** Зарядовая нестабильность параметров МДП-структур при неравномерном распределении тока туннельной инжекции. № 6 стр. 29.
- Усанов Д.А.** Изменение характеристик полупроводниковых приборов при воздействии на них СВЧ-излучения. № 1 стр. 49.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Бабаян А.В.** Взаимосвязь сопротивления диодов Ганна в слабых электрических полях с термостабильностью и выходной мощностью генераторов на их основе. № 5 стр. 31.
- Адамов Д.Ю.** Оптимальное проектирование быстродействующих триггеров на элементах эмиттерно-связанной логики. № 6 стр. 75.
- Адамов Д.Ю., Адамов Ю.Ф., Щелева И.М.** Расчет площади кристалла интегральных микросхем на арсениде галлия. № 3-4 стр. 80.
- Ануфриев В.Н., Семенов М.Ю.** Реализация генераторов частоты с ФАПЧ на основе БМК K5501ХМЗ и ПЛИС Xilinx семейства XC3000. № 2 стр. 80.
- Бобков В.Ю., Дубовой Н.Д.** Эффективность систем спутниковой связи. № 2 стр. 76.
- Богословский В.В., Кривошапко В.М., Левицкий Д.О.** Метод сверхбыстрой оценки полноты логико-динамических тестов СБИС. № 3-4 стр. 93.
- Горлов М.И., Строгонов А.В.** Прогнозирование долговечности ИС методом нестационарных временных рядов. № 2 стр. 63.
- Данилин А.А., Щемелинин В.М.** Программная реализация трассировки свичбокса. № 3-4 стр. 75.
- Кокин С.А., Макаров С.В., Перминов В.Н.** Использование табличных представлений моделей активных элементов при схемотехническом моделировании БИС. № 5 стр. 71.
- Коноплев Б.Г., Рындин Е.А.** Метод определения перегрева кристаллов СБИС на основе элементов с “гибкой цоколевкой”. № 6 стр. 69.
- Коноплев Б.Г., Рындин Е.А.** Оценка эффективности использования элементов с “гибкой цоколевкой” выводов для проектирования заказных СБИС. № 5 стр. 57.
- Коробков А.И., Павлов М.Ю., Шагурина И.И.** Методы и средства повышения тестируемости цифровых СБИС. № 3-4 стр. 85.
- Кривошапко В.М., Рыбаков В.В.** Специализированный JTAG-тестер межсоединений

печатных плат. № 2 стр. 68.

Старосельский В.И., Кобзев Ю.М. Высоколинейные широкополосные усилительные каскады для GaAs ПТШ интегральной технологии. № 1 стр. 63.

Сырцов И.А., Щемелинин В.М. Оптимизация топологии СБИС с использованием иерархических моделей. № 5 стр. 63.

Трояновский В.М. Об адекватном математическом аппарате при моделировании действующих объектов. № 6 стр. 83.

Щемелинин В.М. Метод трассировки сложных схем. № 1 стр. 68.

Щемелинин В.М. Методология мозаичного синтеза конструкций сложных электронных приборов. № 3-4 стр. 69.

Микропроцессорная техника

Антонов А.П., Мелехин В.Ф., Филиппов А.С. Специализированные СБИС в устройствах микропроцессорной техники: средства, инструментарий, технология проектирования. № 1 стр. 84.

Бажанов Е.И. Аналого-цифровое вычислительное устройство: проблемы и перспективы. № 3-4 стр. 106.

Каляев И.А., Катаев О.В., Мельник Э.В. Метод снижения издержек реализации контроля потока управления. № 2 стр. 83.

Каляев А.В., Фрадкин Б.Г., Левин И.И. Унифицированная элементная база для построения реконфигурируемых под задачу вычислительных систем. № 1 стр. 75.

Каляев И.А. Однородные нейроразподобные структуры в системах выбора действий интеллектуальных роботов. № 3-4 стр. 99.

Степанов Н.В. Применение однокристалльной микроЭВМ 1830BE31 для управления лазерной системой. № 6 стр. 93.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Петров Б.Е., Кислый А.А. Стабилизация частоты транзисторного СВЧ автогенератора резонатором на объемных акустических волнах. № 1 стр. 92.

Чистюхин В.В., Кашаев Н.К. Разработка методики оптимизации по числу элементов многолучевой проходной апланатической решетки. № 2 стр. 87.

Чистюхин В.В., Кашаев Н.К. Физические основы расширения рабочего сектора углов многолучевых антенных устройств, построенных на базе апланатических проходных решеток. № 1 стр. 98.

Методы и техника измерений

Абакумов А.А., Абакумов А.А. (мл.), Галушков А.И., Чаплыгин Ю.А. Полупроводниковые сканеры распределенного магнитного поля. № 3-4 стр. 117.

Волков С.И., Григорашвили Ю.Е. Сверхпроводниковый концентратор магнитного поля. № 3-4 стр. 141.

Гундырев В.Б., Краснов И.В., Погибельская Н.Б. Применение метода селективного фототермолиза для устранения косметических дефектов, связанных с гиперпигментацией кожи. № 2 стр. 93.

Жигальский Г.П., Зайцев В.В. Неразрушающий контроль качества контактов резистивных структур по параметрам нелинейности вольт-амперной характеристики.

№ 5 стр. 79.

Котельников В.А., Котельников М.В., Кубарев Ю.В. Метод диагностики разреженных потоков плазмы с помощью плоских ориентированных зондов. № 6 стр.

Кубарев Ю.В., Котельников М.В. Метод зондовой диагностики нестационарных процессов в плазме. № 1 стр. 103.

Никитин Ю.Б., Тикменов В.Н., Шишкевич А.А. Портативные системы мониторинга и регистрации телеметрической информации в информационно-управляющих вычислительных системах реального времени. № 3-4 стр. 135.

Новиков Ю.А., Раков А.В. Прототип линейной меры ширины линии для измерений элементов СБИС на растровом электронном микроскопе. № 3-4 стр. 126.

Поголов А.И., Панкратов О.В. Механические и метрологические характеристики интегральных пьезорезистивных акселерометров. № 5 стр. 85.

Тарасов Ю.А., Ковалев А.В. Структурно-модульное устройство измерения и стабилизации температуры. № 1 стр. 107.

Титов В.С., Дегтярев С.В., Ширабакина Т.А., Струков В.В. Оптико-электронный измеритель линейных перемещений подвижного объекта на фоточувствительном приборе с зарядовой связью. № 3-4 стр. 130.

Яремчук А.Ф., Павлов А.С., Эйдельман Б.Л., Раскин А.А., Звероловлев В.Н. Неразрушающий метод измерения времени жизни неосновных носителей заряда в кремнии. № 2 стр. 96.

Биомедицинская электроника

Терещенко С.А. О диффузионном приближении уравнения переноса излучения. № 6 стр. 101.

Проблемы высшего образования

Безручко В.Т., Масленников В.В. Компьютерные обучающие программы “Введение в микролитографию” и “Материалы для микролитографии”. № 3-4 стр. 147.

Селищев С.В. Достижения и тенденции развития биомедицинской электроники как междисциплинарной области в науке, технике и высшем образовании. № 5 стр. 91.

Краткие сообщения

Ануфриев В.Н., Воробьев В.А., Дягилев И.В., Ионкин В.И., Семенов М.Ю. Разработка и использование триггера Шмитта на базе БМК 1515X1. № 3-4 стр. 153.

Бирюк Н.Д. Колебательный контур в электро- и радиоизмерениях. № 3-4 стр. 151.

Короленко Е.В. Повышение устойчивости устройств на бескорпусных элементах к акустическим воздействиям. № 3-4 стр. 155.

Конференции. Семинары

Всероссийская научно-техническая конференция “Электроника и информатика-97”. № 2 стр. 101.

Глазов В.М., Пашинкин А.С. Информационное сообщение о V Международной конференции “Термодинамика и материаловедение полупроводников”. № 5 стр. 97.

Информационное сообщение о II Всероссийской научно-технической конференции “Электроника и информатика”. № 1 стр. 118.

Пискунов Д.И. Информационное сообщение о Международном согласительном семинаре Восток -Запад по сетевым технологиям для образования и обучения и о Демонстрации телекоммуникационных продуктов и технологий. № 5 стр. 98.

Информационное сообщение о Второй Всероссийской научно-технической конференции с международным участием “Электроника и информатика”. № 6 стр. 106.

Информационное сообщение о семинаре на тему “Подготовка разработчиков специализированных микросхем. Опыт и перспективы”. № 6 стр. 107.

Общероссийская научно-техническая конференция с международным участием “Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники”. № 6 стр. 108.